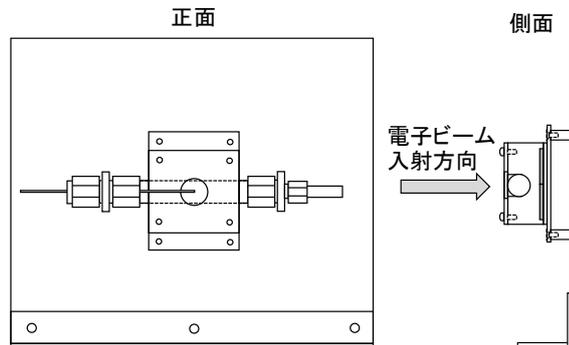


ライナック電子線材料照射装置

1. 概要

高温域または低温域で材料のライナック電子線照射が可能な装置である。温度域に応じて試料ホルダーを使い分ける。



2. 特性

図1 ライナック電子線高温照射試料ホルダー

照射温度：高温域 室温～673K (He 雰囲気
気中照射)、低温域 100K (液体窒素中照射)

電子線エネルギー：高温域 低エネルギー加速(～8MeV)、低温域 高エネルギー加速(～30MeV)

3. 設置場所

電子線型加速器施設 (中性子発生装置室)

4. 提出書類

実験計画に使用の旨を記載、管理区域立入願

5. 装置担当者

木野村淳 (2682)、徐虬(2417)